



北京化工大学

Beijing University of Chemical Technology

信号与系统

第二章 连续时间系统的时域分析

主讲教师：张凤元

主要内容

CONTENTS



- 1 连续时间系统响应的时域分析
- 2 连续时间系统初始条件的确定
- 3 连续LTI系统的零输入和零状态响应
- 4 信号的线性卷积
- 5 离散时间LTI系统的时域分析法
- 6 信号的变换域分析简介



1

连续时间信号的时域分析

- 方程齐次解
- 方程特解
- 方程通解
- 初始条件
- 经典解法



1.1 系统数学模型的时域表示

时域分析方法:不涉及任何变换,直接求解系统的微分、积分方程式,这种方法比较直观,物理概念比较清楚,是学习各种变换域方法的基础。

输入输出描述:一元 n 阶微分方程

状态变量描述: n 元一阶微分方程

本课程中我们主要讨论输入、输出描述法

1.2 系统分析的一般过程

列写系统的微分方程：根据元件约束,网络拓扑约束等

解方程求解系统响应 $r(t)$ ：

- 经典法
- 双零法
 - 零输入响应
 - 零状态响应
- 变换域法

经典法：求解常系数线性微分方程的一般方法；

零输入响应：可以用经典法求解。

零状态响应：任意激励 $e(t)$ 下的零状态响应 $r_{zs}(t)$ 可通过冲激响 $h(t)$ 应用卷积法来计算。

1.3 物理系统的微分方程模型

- 许多实际系统可以用线性系统来模拟。
- 对于线性时不变系统，系统的参数不随时间而改变，这样的系统可以用**线性常系数微分方程**模型描述。
- 经典解法中，对于高阶系统或激励输入信号较复杂时，求解系统响应时计算过程复杂，求解并不方便。而在变换域中求解显得比较方便。所以人们的兴趣更集中于变换域分析。

1.4 微分方程的列写方法

- 一般根据实际系统的物理特性列写系统的微分方程。
- 对于电路系统，主要是根据**元件特性约束**和**网络拓扑约束**列写系统的微分方程。

元件特性约束：表征元件特性的关系式。例如二端元件电阻，电容，电感各自的电压与电流的关系，以及四端元件互感的初、次级电压与电流的关系等等。

网络拓扑约束：由网络结构决定的电压电流约束关系，KCL, KVL.

1.5 n 阶线性时不变系统的描述

一个线性系统，其激励信号 $e(t)$ 与响应信号 $r(t)$ 之间的关系，可以用下列形式的微分方程式来描述。

$$C_0 \frac{d^n r(t)}{dt^n} + C_1 \frac{d^{n-1} r(t)}{dt^{n-1}} + \cdots + C_{n-1} \frac{dr(t)}{dt} + C_n r(t) = E_0 \frac{d^m e(t)}{dt^m} + E_1 \frac{d^{m-1} e(t)}{dt^{m-1}} + \cdots + E_{m-1} \frac{de(t)}{dt} + E_m e(t)$$

系统为时不变的，则 C ， E 均为常数，此方程为常系数的 n 阶线性常微分方程。

阶次 n ：方程的阶次 n 由独立的动态元件的个数决定。

1.6 求解系统微分方程的经典法

分析系统的经典方法：

- (1) 列写常系数线性微分方程；
- (2) 求方程对应的齐次方程的通解；
- (3) 求方程的一个特解；
- (4) 方程的通解 = 齐次解 + 特解；
- (5) 将初始条件代入通解得到完全响应。

我们一般将激励信号加入的时刻定义为0，响应为 $t \geq 0_+$ 时方程的解，初始条件

$$r(0^+), \frac{dr(0^+)}{dt}, \frac{d^2 r(0^+)}{dt^2}, \dots, \frac{d^{n-1} r(0^+)}{dt^{n-1}}$$

1.7 几种典型激励函数相应的特解形式

激励函数 $e(t)$	响应函数 $r(t)$ 的特解
$E(\text{常数})$	$B(\text{常数})$
t^p	$B_1 t^p + B_2 t^{p-1} + \cdots + B_p t + B_{p+1}$
$e^{\alpha t}$	$B e^{\alpha t}$
$\cos(\omega t)$	$B_1 \cos(\omega t) + B_2 \sin(\omega t)$
$\sin(\omega t)$	
$t^p e^{\alpha t} \sin(\omega t)$	$(B_1 t^p + B_2 t^{p-1} + \cdots + B_p t + B_{p+1}) e^{\alpha t} \cos(\omega t)$
$t^p e^{\alpha t} \cos(\omega t)$	$+ (D_1 t^p + D_2 t^{p-1} + \cdots + D_p t + D_{p+1}) e^{\alpha t} \sin(\omega t)$

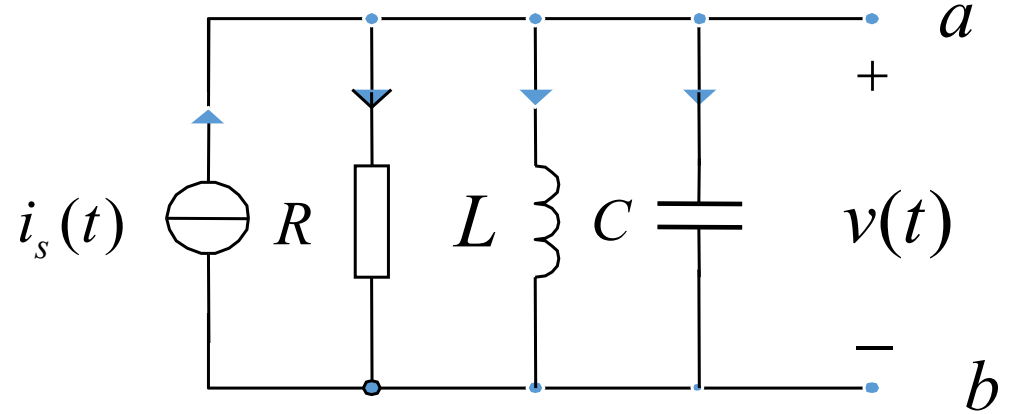
1.8 例1 求并联电路的端电压 $v(t)$ 与激励 $i_s(t)$ 间的关系

解答

电阻 $i_R(t) = \frac{1}{R} v(t)$

电感 $i_L(t) = \frac{1}{L} \int_{-\infty}^t v(\tau) d\tau$

电容 $i_C(t) = C \frac{dv(t)}{dt}$



根据KCL $i_R(t) + i_L(t) + i_C(t) = i_s(t)$

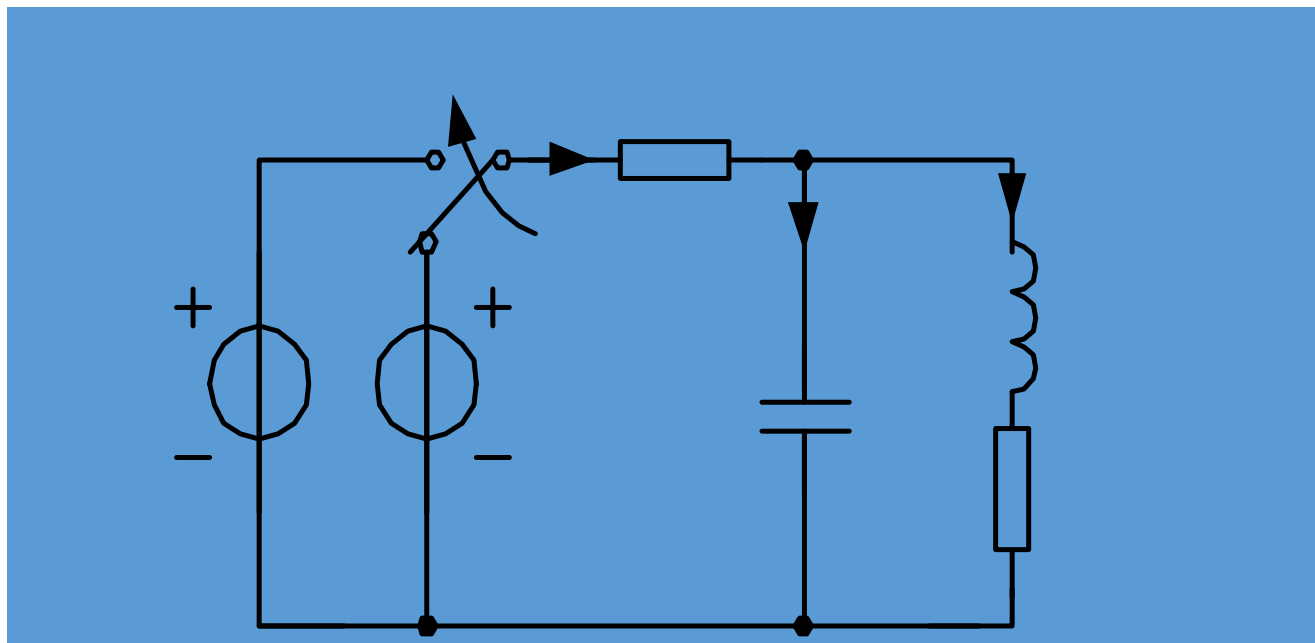
代入上面元件伏安关系，并化简有 $C \frac{d^2 v(t)}{dt^2} + \frac{1}{R} \frac{dv(t)}{dt} + \frac{1}{L} v(t) = \frac{di_s(t)}{dt}$

这是一个代表RCL并联电路系统的二阶微分方程。

1.9 例2 求解系统微分方程的经典法



给定如图所示电路 $t=0$ 时开关S位于1的位置而且已经达到稳态；当 $t=0$ 时，S由1转向2。试建立 $i(t)$ 电流的微分方程，并求解 $i(t)$ 在 $t \geq 0$ 时的变化。



1.9 例2 求解系统微分方程的经典法

解答

(1) 列写电路的微分方程

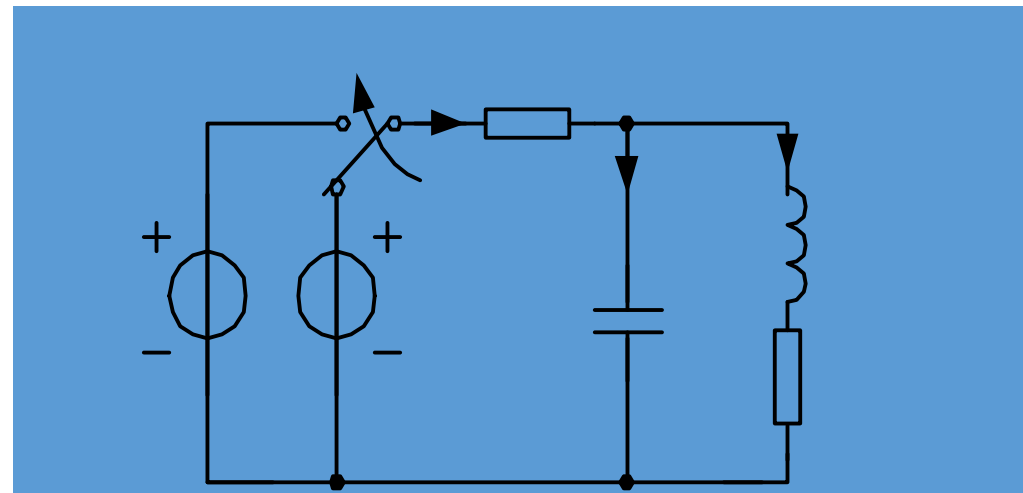
$$R_1 i(t) + v_c(t) = e(t)$$

$$v_c(t) = L \frac{d}{dt} i_L(t) + i_L(t) R_2 \quad \text{结点电压}$$

$$i(t) = C \frac{d}{dt} v_c(t) + i_L(t) \quad \text{回路方程}$$

$$\frac{d^2}{dt^2} i(t) + 7 \frac{d}{dt} i(t) + 10 i(t) = \frac{d^2}{dt^2} e(t) + 6 \frac{d}{dt} e(t) + 4 e(t)$$

消去中间变量



(2) 求系统的完全响应通解

系统的特征方程：

$$\alpha^2 + 7\alpha + 10 = 0 \quad , \quad (\alpha + 2)(\alpha + 5) = 0$$

特征根：

$$\alpha_1 = -2, \quad \alpha_2 = -5$$

齐次通解：

$$i_h(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-5t} \quad (t \geq 0_+)$$

非齐次特解:

由于 $t \geq 0_+$ 时 $e(t) = 4V$

方程右端自由项为 4×4 , 因此令特解 $i_p(t) = B$,

$$10B = 4 \times 4 \quad \therefore B = \frac{16}{10} = \frac{8}{5}$$

要求系统的完全响应为:

$$i(t) = A_1 e^{-2t} + A_2 e^{-5t} + \frac{8}{5} \quad (t \geq 0_+)$$

(3) 求系统的完全响应

开关S从1切换到2后，系统的初始条件为：

$$r(0_+) = \frac{14}{5} A \quad \frac{dr}{dt}(0_+) = -2 A / s$$

将初始条件代入通解得：

$$\begin{cases} i(0_+) = A_1 + A_2 + \frac{8}{5} = \frac{14}{5} \\ \frac{d}{dt}i(0_+) = -2A_1 - 5A_2 = -2 \end{cases} \quad \begin{cases} A_1 = \frac{4}{3} \\ A_2 = -\frac{2}{15} \end{cases}$$

完全响应为：

$$i(t) = \left(\frac{4}{3} e^{-2t} - \frac{2}{15} e^{-5t} + \frac{8}{5} \right) A \quad (t \geq 0_+)$$



谢谢大家，下讲再见！



北京化工大学
BEIJING UNIVERSITY OF CHEMICAL TECHNOLOGY

新闻网